



用于超导磁约束聚变装置第一壁表面的离子回旋硼化工艺

文献类型: 专利

...

作者 胡建生¹; 龚先祖¹; 万宝年¹; 赵燕平¹; 李建刚¹

发表日期 2000-12-27

专利国别 中国

专利号 cn1278018

专利类型 发明

权利人 中国科学院等离子体物理研究所

是否PCT专利 是

学科主题 应用超导技术

公开日期 2009-10-15 ; 2009-10-15

申请日期 2000-06-12

专利申请号 cn00112333

源URL [<http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/50>]

专题 合肥物质科学研究院_中科院等离子体物理研究所

推荐引用方式 胡建生,龚先祖,万宝年,等. 用于超导磁约束聚变装置第一壁表面的离子回旋硼化工艺, 用于超导磁约束聚变装置第一壁表面的离子回旋硼化工艺, 用于超导磁约束聚变装置第一壁表面的离子回旋硼化工艺, 用于超导磁约束聚变装置第一壁表面的离子回旋硼化工艺. cn1278018. 2000-12-27.
GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [合肥物质科学研究院](#)

浏览	下载	收藏
625	129	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。